

labolsa.com

Visítalo en:

<http://www.labolsa.com/noticias/20190422111000897/los-cientificos-de-la-nthu-optimizan-la-mram-de-ultima-generacion>

Los científicos de la NTHU optimizan la MRAM de última generación

22 de Abril de 2019, 11:10|

La memoria de acceso aleatorio magnetorresistiva (Magnetoresistive random access memory, MRAM) es el candidato de vanguardia para la próxima generación de tecnologías digitales. Sin embargo, el manejo eficiente y efectivo de la MRAM ha resultado todo un reto. Un equipo de investigación interdisciplinario que opera en la Universidad Nacional Tsing Hua (NTHU) de Taiwán, dirigido por el Prof. Chih-Huang Lai y el Prof. Hsiu-Hau Lin, hizo un descubrimiento revolucionario: al añadir una capa de platino de muy pocos nanómetros de espesor, la MRAM genera una corriente de spin para cambiar a voluntad los momentos magnéticos asociados con la fuerza de anclaje, una tarea que nunca se ha realizado antes.

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

- Business Wire